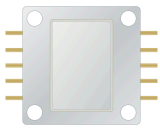
13400–14600 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 44.5 dBm (typisch)

LCI-PA-13400-14600-PS44p5T · 13400–14600 MHz · GaN Gehäuster Leistungsverstärker.



Kennwerte der RF-Tabelle: PSAT 44.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 19.5 dB (typisch); PAE 32 % (typisch). RF-Prüfbedingungen: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; CW.

CMW017C

Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 5

RFin: 3

Vd: 6, 10

RFout: 8

NC: 2, 4, 7, 9

Gehäuseabmessungen: 15.25 × 15.25 × 1.4 mm.

RF-Kennwerte

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; CW

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	13400	-	14600	MHz
Sättigungsausgangsleistung	-	43.7	44.5	-	dBm
Leistungsverstärkung	-	-	19.5	-	dB
Leistungsaddierte Effizienz	-	28	32	-	%
Welligkeit der Leistungsverstärkung	-	-	-	±0.6	dB
Kleinsignalverstärkung	S21	-	28	-	dB

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung	-	-	-	-	28	V
Gatespannung	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	-	-	-	32	V
Minimale Gate-Vorspannung	-	-5	-	-	V
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	28	dBm

Gehäuseabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Gehäuseabmessungen	15.25 × 15.25 × 1.4	mm

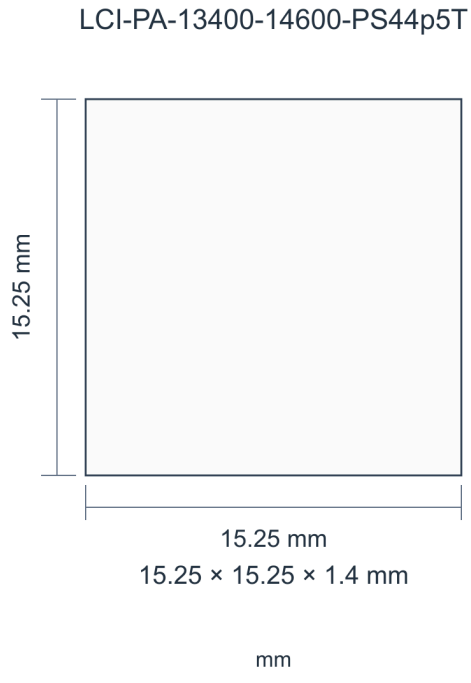
Aktueller Publikationsstand · 1.8 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.7.

Integrationshinweise

CMW017C Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 5 RFin: 3 Vd: 6, 10 RFout: 8 NC: 2, 4, 7, 9

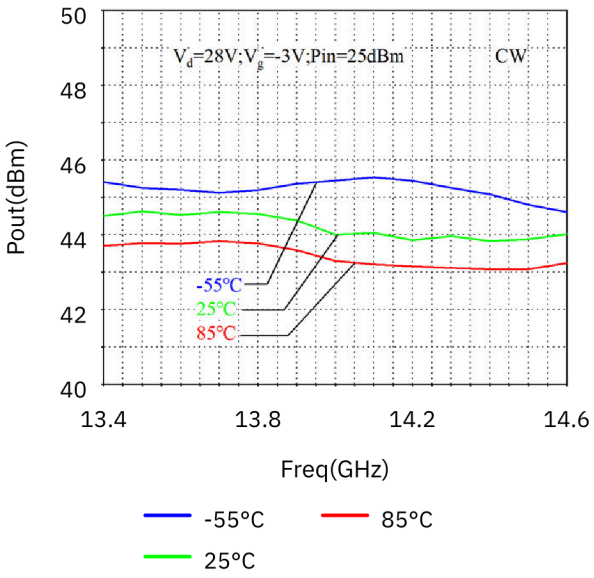
Mechanische Maßzeichnung

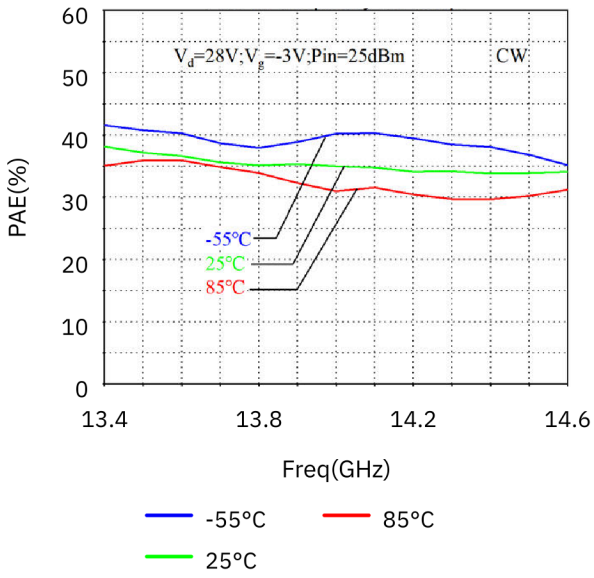
Teilzeichnung mit bestätigten Abmessungen in mm. Für die Montage ist der vollständige Montageplan erforderlich.

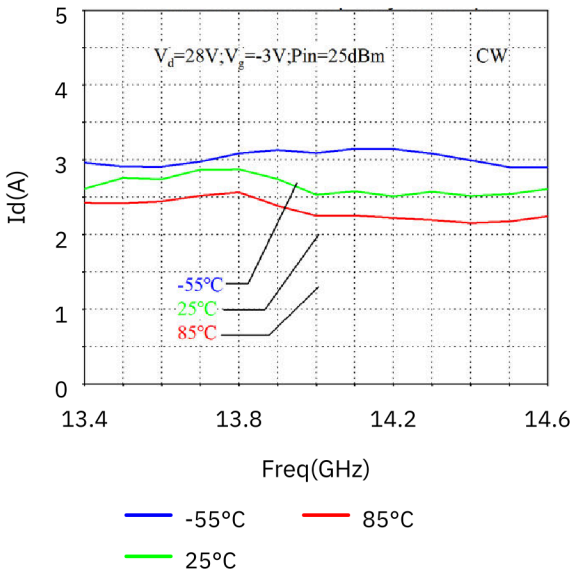


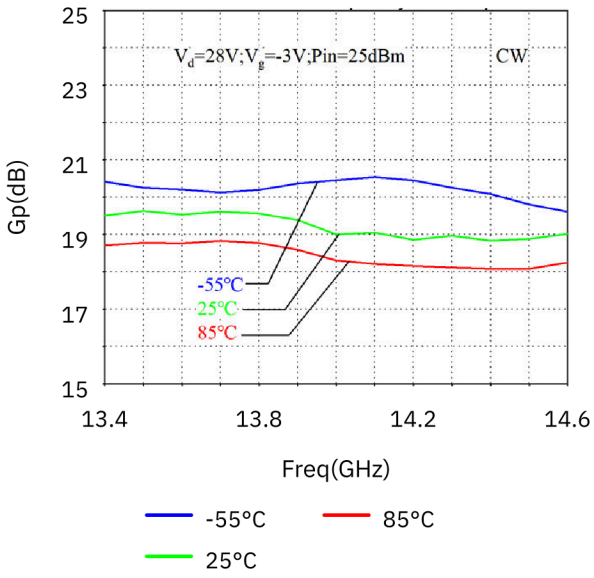
Kennlinien

Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

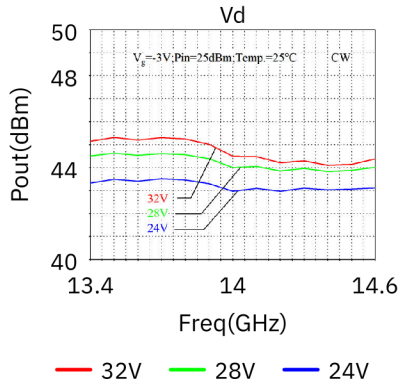


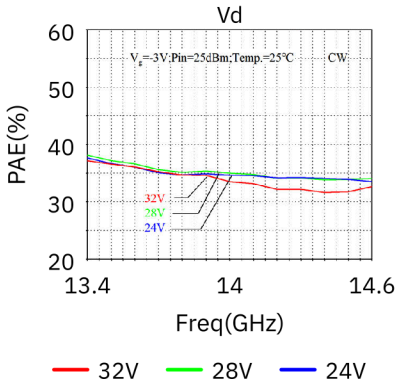


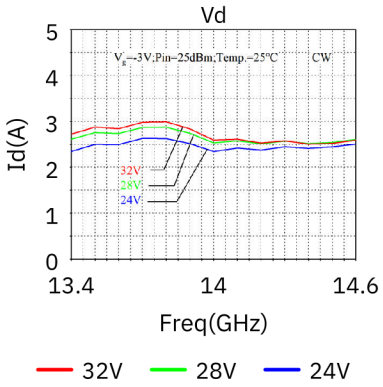


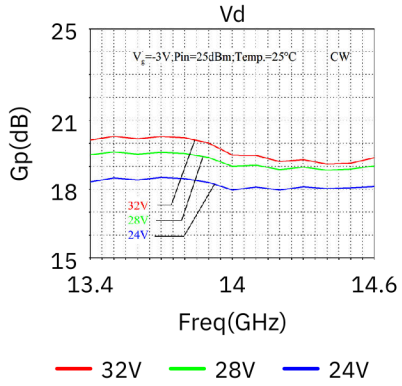


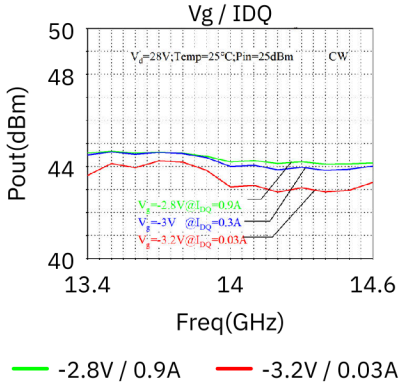
Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Drainstrom; Leistungsverstärkung. Vd = 28 V; Vg = -3 V; Pin = 25 dBm; CW; T = -55/25/85 °C.

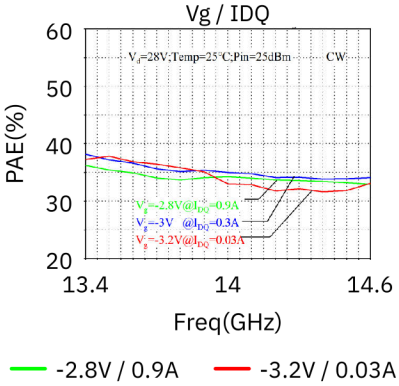


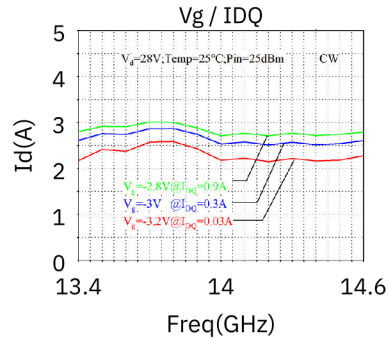


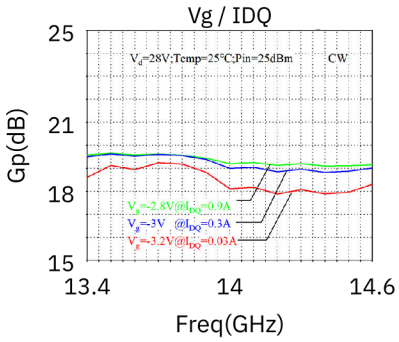




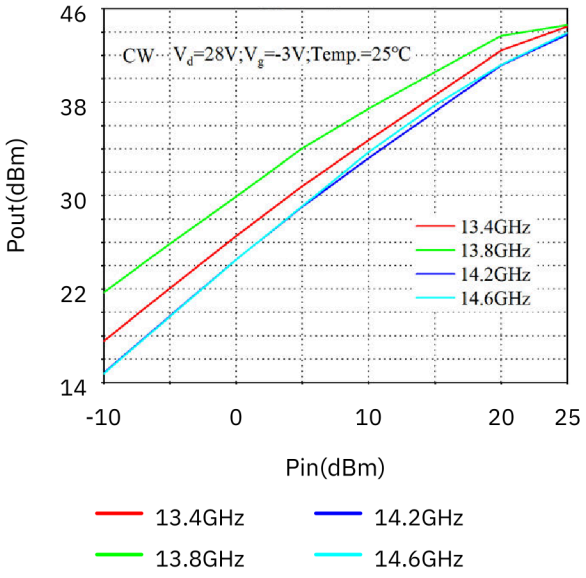


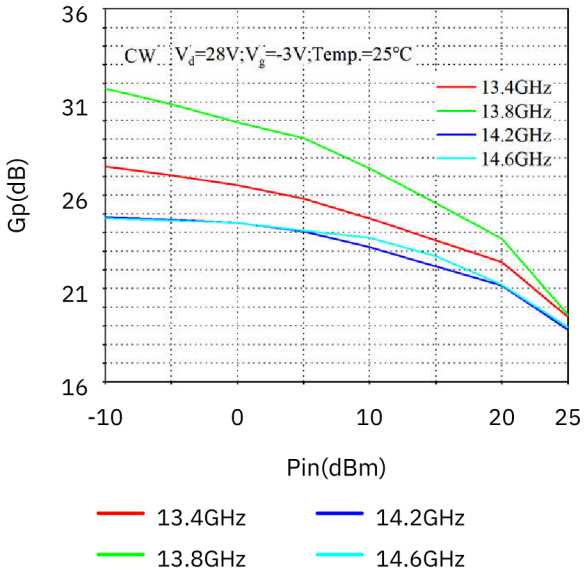


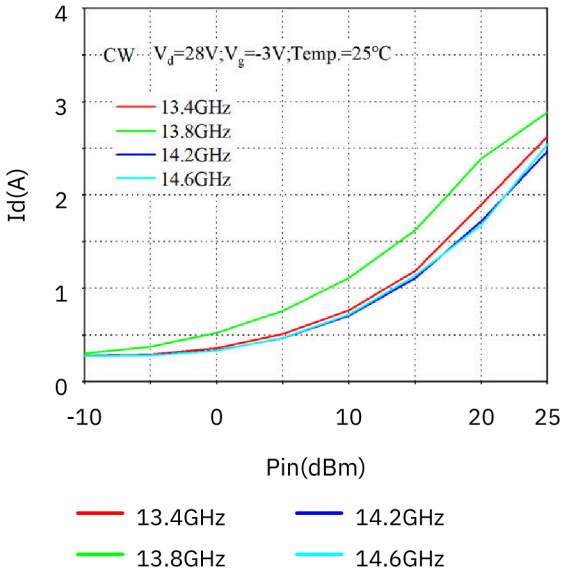




Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Drainstrom; Leistungsverstärkung. CW; TA = 25 °C; Pin = 25 dBm. Diagramme 1–4: Vg = -3 V; Vd = 32/28/24 V. Diagramme 5–8: Vd = 28 V; Vg = -2.8 V/IDQ = 0.9 A, -3 V/IDQ = 0.3 A, -3.2 V/IDQ = 0.03 A. Die Leistungsverstärkung Gp ist in dB angegeben.







Pout(dBm); Gp(dB); Id(A). CW; Vd = 28 V; Vg = -3 V; TA = 25 °C; Pin = -10...25 dBm; f = 13.4/13.8/14.2/14.6 GHz.

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.